A Study on Steady-State Resistances of Horizontal Grounding Mesh and Conducting Plates

Takeo FUJIWARA*, Keisuke NAKAMURA*, Akihiro AMETANI*, Naoto NAGAOKA*, Yoshihiro BABA*

(Received March 12, 2014)

This paper investigates the steady-state resistances of horizontal grounding electrodes based on experimental measurements, FDTD(Finite-Difference Time-Domain) simulations and analytical formula. The resistance of a grounding mesh is compared with that of a horizontal conducting plate considering the area and the shape. Finally an approximate formula to estimate grounding resistance is developed.

Key words : Grounding electrode, grounding mesh, conducting plate, steady-state resistance, FDTD simulation

キーワード:接地電極,接地網,平板状電極,定常抵抗,FDTD シミュレーション

水平網状および平板状接地電極の定常接地抵抗に関する研究

藤原 健生*,中村 圭佑*,雨谷 昭弘*,長岡 直人*,馬場 吉弘*

1. はじめに

水平接地極は多数の電極を互いに接続すること で大地との接触面積を容易に大きくすることが可 能であり,低接地抵抗を得られるため広く利用され ている¹⁾.日本では大地抵抗率の高い山岳地帯でも 風力電などの発変電設備が多く建設されている.山 岳地帯では岩場などを避けて設備を建設するため 建設用地が限られており,大規模な水平接地極は建 設できない.従って,狭い敷地の中で,できるだけ 接地抵抗を低くできる水平電極の検討が必要であ る.接地網(メッシュ)の接地抵抗推定式では,その 表面積を円板と等価と仮定しており,電極の形状や 面積の影響は十分に検討されておらず,その特性は 明らかであるとは言い難い^{2,3)}.

本研究では、水平接地極として棒状電極および板 状電極を用い、その接地抵抗特性を測定し、電極の 形状や面積の影響について検討を行う.また、数値 電磁解解析の一手法である有限差分時間領域法 (Finite-Difference Time-Domain Method: FDTD法)⁴⁾ を用いたシミュレーションを行い、実験結果と比 較・検討する.これらの結果に基づき網状電極にお ける接地抵抗推定式を導出する.

^{*}Faculty of Science and Engineering, Doshisha University, Kyoto

Telephone: +81-744-65-6352, FAX:+81-744-65-6801, E-mail: aametani@mail.doshisha.ac.jp

2. 水平単電極の接地抵抗理論式

2.1. 単電極

$$R(r) = \frac{\rho}{2\pi l} \left[\ln \frac{l}{r} \left\{ 1 + \sqrt{1 + \left(\frac{r}{l}\right)^2} \right\} + \frac{r}{l} - \sqrt{1 + \left(\frac{r}{l}\right)^2} \right]$$
(1)

ここで,rは電極の半径[m],lは電極の長さ[m]である. さらに $r \ll l$ として,(1)式は次のように近似できる.

$$R(r) = \frac{\rho}{2\pi l} \left(\ln \frac{2l}{r} - 1 \right) \tag{2}$$

埋設深さを考慮する場合には地表面に対する影像 を用いる. 電極の埋設深度がd[m]のとき, Fig. 1 に 示すように全空間を抵抗率 ρ [Ω m]の媒質で満たし, 地表面に対して上方 2d[m]の位置に影像を考える. 影像による影響は(1)式における電極の半径 r を導 体間の距離 2d に置き換えたものに等しく次式で表 される.

$$R(2d) = \frac{\rho}{2\pi l} \left[\ln \frac{l}{2d} \left\{ 1 + \sqrt{1 + \left(\frac{2d}{l}\right)^2} \right\} + \frac{2d}{l} - \sqrt{1 + \left(\frac{2d}{l}\right)^2} \right]$$
(3)

影像を考慮した水平単電極接地抵抗 *R*_hは(1)式と(4) 式の和として与えられる.

$$R_{h} = R(r) + R(2d) \tag{4}$$





2.2 板状電極

楕円状電極の短径を軸にして回転させた場合に 得られる立体について,周囲の抵抗率が ρ [Ω m]で満 たされている場合の抵抗 R は次式で与えられてい る^{1,2}.

$$R = (\rho/4\pi er) \arcsin(e)$$

$$\Xi \equiv \overline{C},$$
(5)

$$e = \sqrt{1 - \left(l/r\right)^2} \tag{6}$$

$$R_{Plate} = \rho/8r \tag{7}$$

平状電極の接地抵抗を算出する場合,電極を円板と みなす手法が用いられる.従って,板状電極の面積 を *A* [m²]とするとき,次式により算出される等価半 径 *r* を(7)式に代入すればよい.

$$r = \sqrt{A/\pi} \tag{8}$$

埋設時における板状電極の接地抵抗理論式は影像による影響を考慮すると次式で与えられる²⁾.

$$R_{Plate} = \left(\rho/4\pi\right)\left(1 - 4d/\pi r\right) \tag{9}$$

ここで, ρ:大地抵抗率[Ω m], r:(8)式で与えられ る等価半径[m], d: 埋設深さ[m]

3. 水平接地極単電極

本章では、水平接地極として Fig. 2 に示すような 最も単純な水平接地単電極について検討を行う.

3.1. 過渡応答実験

(1) 実験条件

実験配置図を Fig. 2 に示す. 接地電極としては半径 0.01 m, 長さ 0.6 m の棒状電極を用い, 0.3 m の 深さにビニル被覆線(KHD 1.75)を介して埋設して いる.

本実験では、電圧源に Pulse Generator (NoiseKen INS-4020)を用いており、試験電極から 40 m 遠方に 配置している.電流印加線には同軸ケーブル(3D2V) を用いて埋設線直上まで導き、5 k Ω の高抵抗を介 して試験電極へ Fig. 3 に示すような立ち上がり約 15 ns,波高値 1A の電流を注入している.なお、印 加電圧は注入電流波高値が 1A となるように設定し ている.電圧基準線にビニル被覆線を用い、電流注 入線に対して直交するように配置し, 25 m 遠方で 接地している.

Wenner の 4 電極法¹⁾により接地抵抗・大地抵抗 率計 KEW4106 (共立電気計器 社製)を用いて,実験 場大地の抵抗率を測定したところ,2層構造と推測 され,深さ 2.5 m までの第1層は抵抗率 400 Ωm で あり,以降の第2層は 520 Ωm であった.



Fig. 2. Experimental setup.



Fig. 3. Injected current.

(2) 測定機器

オシロスコープは DPO - 4104 (Tektronix 社製)で あり, DC~1 GHz の周波数帯域を有している. 電 圧測定には, 受動プローブ P6139A (Tektronix 社製) を用いた. P6139A は DC~500 MHz の周波数帯域 を有しており,入力容量は 8 pF である. 高圧プロ ーブ P5100 (Tektronix 社製)は DC~250 MHz の周波 数帯を有しており,入力容量は 2.75 pF である. 電 流測定には AC 電流プローブ CT -1 (Tektronix 社製) を用いた. CT-1 は 25kHz~1GHz の周波数帯域を有 し,感度は 5 mV/mA である.

3.2. FDTD 法の計算条件

解析空間図を Fig. 4 に示す. 解析空間の刻み幅は 全ての方向で *Δs* = 0.05 m とし解析空間の大きさ は *X*, *Y*, *Z* 方向全てにおいて 6.0 m としている. 大地 は厚さ 2.5 m,抵抗率 400 Ω m,比誘電率 20 の物質 を満たすことで模擬している.なお,解析空間を囲 む 6 つの境界面は,Liao の 2 次吸収境界条件を用い て開空間を模擬している.半径 0.01 m,長さ 0.6 m の接地電極は完全導体で模擬しており,地表面下 0.3 m に配置している.また,埋設線としては導体 を導電率 $\sigma = 10^{-12}$ [S/m],比誘電率 $\varepsilon_r = 1$ の直方誘電 体で覆うことでビニル被覆線を模擬している.埋設 線の始端に内部抵抗 5 k Ω の電流源を配置し,図 3 に示した波高値 1 A,立ち上がり約 15 nsの実験と 同様の電流を注入している.電流注入線,および電 位基準線は完全導体で模擬しており,遠方を吸収境 界に接続することで無限長導体を模擬している.



Fig. 4. Analytical space.

3.3. 実験および FDTD 計算結果

Fig. 5 に実験結果および FDTD 法計算結果を重ね て示す. 注入電流に比べて波頭部の立ち上がりが緩 やかになり, 定常接地抵抗と電流の波高値の積算で 求まる定常値へと収束する容量性の波形を示して いる. *t* = 300 ns 付近の定常部分では,実験結果は 416 V, FDTD 法計算では 406 V, Sunde の(4)式理 論値は 404 V で, その差異は 3 %程度に収まってお



り,良好に一致していると言える.また,定常領域 に至るまでの過渡部についても実験結果と計算結 果は概ね一致していることから,本解析モデルを用 いた FDTD 法計算結果は妥当である.従って,FDTD 法による水平接地極の検討が可能であると言える.

4. 水平接地電極の面積形状

本章では板状および網状電極を用いた実験および FDTD 計算により水平接地電極の面積と形状に ついて検討する.

4.1. 網状電極の接地抵抗理論式

4.1.1. 円環状配置電極

直径 D の円環状に配置された直径 2a の電極を
 深さ d の位置に埋設した時の全電極の等価接地抵抗 R_{torus} は次式で与えられている.

$$R_c(D) = \left(\rho/2\pi^2 D\right) \left(\ln\left(4D/\sqrt{2ad}\right)\right) \tag{10}$$

Fig. 6のように等間隔で*M*個に分割されている網状 電極の円環電極による模擬について考える.

(1) 等面積

Fig. 6 のメッシュの面積 *S*に着目し, *M* 個の円環 状電極が並列に接続されているとする. $M \to \infty$ で の収束値が(7)式の板状電極接地抵抗に一致すると 仮定すると,全円環状電極の接地抵抗 R_a は次式で 表される.

$$R_a = (1/M)R_c \left(D/\sqrt{M} \right) + R_P \tag{11}$$

ここで、M: メッシュ数, D: 電極半径、 $R_P=(7)$ 式の接地抵抗[Ω]

(2) 等価外周

メッシュ数 *M* のとき,総導体長 *l*_Mは網状電極の 外周で定まる面積 *A* [m²]を用いて次式で与えられ る.

$$l_M = 2\sqrt{A} \left(\sqrt{M} + 1 \right) \tag{12}$$

従って,総電極長に対する等価半径 r_M は次式により算出できる.

$$r_M = l_M / 2\pi \tag{13}$$

(10)式と(13)式で与えられる接地抵抗 R_cと(7)式の接 地抵抗 R_pの和として全円環電極接地抵抗 R_bを与え る.

$$R_b = R_c \left(2\sqrt{A} \left(\sqrt{M} + 1 \right) / \pi \right) + R_P \tag{14}$$

(3) 等価抵抗

(11)式と(12)式の平均としてメッシュ数 Mのときの網状電極の接地抵抗 R_{mesh}を定義する.

$$R_{mesh} = R_a + R_b \tag{15}$$

4.1.2. 単電極による模擬

Fig. 7 のような同一平面に等間隔 *s* で配置された *k* 本の水平棒状電極を考える.*k* 本の電極には電流 が等しく分流していると仮定すると, 電極の接地抵 抗 *R_k*は次式で与えられる^{1,2)}.

$$R_{k} = (1/k)(R_{h}(r) + (2/k)[(k-1)R_{h}(s) + (k-2)R_{h}(2s) + \dots + R_{h}(ks-s)])$$
(16)

$$R_h(r) = \left(\rho/\pi l\right) \left(\ln\left(2l/\sqrt{2ad}\right) - 1 \right) \tag{17}$$

ここに,k:電極本数, R_h :水平単電極の接地抵抗 [Ω];(4)式, ρ :大地抵抗率[Ω m],s:電極間離隔距 離[m],r:電極半径[m],l:電極長[m],d:埋設深 さ[m].



Fig. 6. Equally spaced grounding mesh.



Fig. 7. *k* parallel conductors on the same plane.

(20)

ると全接地抵抗 R_{mesh}は次式で表すことができる.

$$R_{mesh} = R_k //R_m = R_k R_m / (R_k + R_m)$$
 (18)

4.2. 実験的検討

4.2.1. 実験条件

Fig. 8 に実験配置図を, Fig. 9 と Table 1 に実験対象とした水平接地電極の条件および測定結果を示す. なお,埋設深さは 0.2 m である.網状電極には 直径 4 mm の銅製棒状電極を用い,平板電極として は 1 m×1 m×1 mm のアルミ板を用いた.また,円 板電極に Fig. 9 に示すように平板を加工して作成し た.実験場大地は 2 層構造をなし,深さ 1 m までの 第 1 層は大地抵抗率が 200 Ω m であり,それ以降の 第 2 層は 60 Ω m であった.

4.2.2. 実験結果

Table 1 に実験波形より読み取った t = 300 ns 付近 の電圧値,および電位降下法で測定した抵抗値を示 す. Fig. 10(a)に 0.85 m 四方の平板電極(Case B-1) と網状電極(Case A)の過渡電圧波形を示す.次に, 図 10(b)に平板電極(Case B)と円板電極(Case C)で の過渡電圧波形を示す.

図より, t = 10 ns 付近には 60 V 程度のピーク値 が観測される. これは埋設線始端を観測点としてい るため, 埋設線の有するインダクタンス成分の影響 と考えられる³⁾.

Table 1 より, t = 300 ns 付近の定常値に関して, 実験結果を電位降下法による測定結果と比較する と 20 % 程度の差異が生じている.これは測定に用 いた接地抵抗計(共立電気計社製 KEW 4106)の最 大動作誤差($\pm 30\%$)の範囲内である. Case B-1 で(9) 式で与えられる板状電極の接地抵抗値は 49 Ω であ り,電位降下法で測定した値との差異は 6 %にすぎ ない.従って,実験結果では t = 300 [ns]以降に定常 領域が存在していると推測され,以下の検討では電 位降下法による測定結果を用いる.



Fig. 8. Experimental setup with a connecting wire.



(a) Square plate (b) Mesh (M = 4) (c) Circular plate Fig. 9. Various grounding electrodes.





4.2.3. メッシュと平板電極の等価性

Table 1 において網状電極(Case A)と, 一辺 0.85 m の平板電極(Case B-1)を比較すると, Case A-1 は 15%大, Case A-2 では 0.4%大となっており, 同一 面積の平板では同一抵抗とはならないことが知ら れる.また,円板電極(Case C)の接地抵抗はCase B-1より2% 小にすぎない.

以上より,接地メッシュと板状電極の接地抵値は 一定の相似性を有していることが明らかである.な お,メッシュ係数は *M*=4の場合 *M*₄=1.1 とすれば よい.

Table 1. Experimental conditions and measured

resistances corresponding to Fig. 9.

Case	Туре	<i>a</i> [m]	r *[m]	Size[m ²]	Vs	$R_G^{**}[\Omega]$
A-1	Mesh	0.90	0.51	0.81	48.0	59.9
A-2	Mesh	1.10	0.62	1.21	43.9	52.1
B-1	Square Plate	0.85	0.48	0.72	42.8	51.9
B-2	Square Plate	1.00	0.56	1.00	37.7	46.5
С	Circular Plate	-	0.50	0.78	41.2	50.9

 $\rho = 200\Omega m$, Applied current : rise time $T_f = 15 ns$, amplitude $I_0 = 1 A$ *r : equivalent radius given by eq. (2.21) Vs :Voltage at t=300[ns]

** R_a : measured result with fall of potential method Va:Simulation at 300[ns]

4.3 メッシュ数の検討

実験ケースを Fig. 11 に示す. 0.85 m 四方の平板 電極と 0.85 m 四方の網状電極(*M* = 4, 9, 16) を 0.2 m の深さに埋設している.

実験場の大地抵抗率は 700 Ω m であった.また, 電位降下法による各ケースの接地抵抗を測定した 結果を表 2 にまとめて示している. Table 2 に平板 電極と比較して M=4 では 22%大, M=9 では 2% 大, M=16 では 1%小となっており,メッシュ数が 大となるにつれて平板電極の有する抵抗値へと収 束することがわかる.また, 0.85 m 四方の板状電極 はメッシュ数を 9 とする網状電極と十分に等価と 言える.

4.4 網状電極の接地抵抗理論式の精度検証

本節では4.1節で導出した網状電極における接地 抵抗理論式と実測抵抗値,ならびに FDTD 法を用い た計算結果と比較することにより精度検証を行う.

(1) 実測値との比較

Table 3 に 4.2 節と 4.3 節にて電位降下法により得 られた接地抵抗値,ならびに(16)式と(18)式により 得られる計算結果をまとめている.表より,実測値 と比較して,(16)式による結果は最大 7 %の差異, (18)式では最大 14 %の差異であり,単電極模擬によ る推定結果は概略妥当であると言える.





Fig. 11. Various electrodes used in experiments.

Table 2. Experimental conditions and measured

resistances corresponding to Fig. 11.

Case	Туре	<i>r</i> *[m]	М	Vs	$R_{\rm G}$ **[Ω]
Case D-1	Mesh	0.48	4	111.9	230
Case D-2	Mesh	0.48	9	97.1	193
Case D-3	Mesh	0.48	16	96.2	188
Case E	SQ-Plate	0.48	-	92.0	189
Case F	Circle	0.50	-	89.6	180

 ρ :700 Ωm, Size:0.72m², M : the number of cells in the horizontal grid *r : equivalent radius given by $\sqrt{A/\pi}$, Vs : measured result at t=300[ns] R_G : measured result with fall of potential method

(2) FDTD 法による精度検証

解析空間を Fig. 12 に示す. 空間の刻み幅は $\Delta s = 0.02 \text{ m}$ とし、空間の大きさは X 方向: 6 m, Y 方向: 6 m, Z 方向: 6.2m としている.大地は厚さ 2.2 m, 抵抗率 200 Ω m, 誘電率 20 の媒質で模擬している. 計算は 2 m × 2 m の網状電極においてメッシュ数 M= 4, 9, 16, 64, 81 を対象としている.(16)式と(18) 式,ならびに FDTD 法による計算結果を Table 4 に 示し、メッシュ数 M との関係を Fig. 13 に示す.表 より、FDTD 法による計算結果と比較して、(16)式 による結果は最大 30 %の差異,(9)式では最大 11 % の差異となっており、両式の結果は良好に一致して いる.また、Fig. 13 より、メッシュ数が大となるに つれて、板状電極の有する接地抵抗に収束しており、 定性的にも一致している.以上より、接地抵抗推定 式は実用上十分な精度を有していると言える.

115



Fig. 12. Analytical space for an FDTD simulation.

Table 3. Measured result $R_{\rm G}$ and calculated results by equations (16) and (18).

Case	$\rho \ [\Omega m]$	<i>a</i> [m]	М	$R_{\rm G}[\Omega]$	Eq. (16)	Eq. (18)
A-1	200	0.9	4	59.9	68.2	58.5
A-2		1.1	4	52.1	57.8	50.8
D-1	700	0.85	4	230	202	213
D-2			9	193	183	192
D-3			16	188	173	181

M: the number of the cells in the grid

 $R_{\rm G}$: measured result with the fall of the potential method

Table 4. FDTD simulation result $V_{\rm s}$ and calculated

Туре	М	Vs	Eq. (16)	Eq. (18)
	1	42.3	47.6	58.5
	4	36.2	33.1	36.2
	9	29.7	30.0	32.2
	16	28.8	28.3	30.0
Mesh	25	28.2	27.3	28.6
	36	27.7	26.5	27.7
	49	27.4	26.0	27.0
	64	27.1	25.7	26.4
	81	26.9	25.4	26.0
Plate	-	25.3	-	-

results by equations (16) and (18).

Size of the grid : 2 m \times 2 m, Earth resittivity : 200 $~\Omega m$

M: the number of the cells in the grid, Vs: the voltage value at t = 300 ns



Fig. 13. FDTD simulation results and theoretical results as a function of *M*.

5. 結言

本論文では,棒状電極及び板状電極を用い水平接 地電極の面積・形状に関して,過渡応答実験および 数値電磁界解析の一手法である FDTD 法を用いた 計算結果により検討を行った.また,網状電極にお ける接地抵抗理論式を導出し,精度検証を行った. これらの検討結果より,次の結論を得た.

(1) 水平単電極において,大地抵抗率が大となると, 大地は絶縁体に近い特性を示し,電極終端まで電流 が到達するようになるため,大地誘電率の影響が顕 著になる.また,電極終端が開放状態と見なせるた め,電極終端電位の過渡ピーク値が電極中央より大 となる.

(2) 網状電極においても板状電極と同様に等価半径から接地抵抗を求めることが可能である.

(3) 網状電極を単電極,および円環電極により模擬 することで導出した接地抵抗推定式は実用上満足 できる精度を有している.

参考文献

- 1) 川瀬太郎,現場の接地技術と接地システム,(オーム社, 東京, 1993), pp.1-140.
- E.D.Sunde, Earth conduction effects in transmission system, (Dover Publications, Inc., New York, 1968), pp.1-373.
- 3) 雨谷昭弘,森井浩,久保隆,"接地電極過渡応答理論 式の導出と測定結果の検討",電気学会論文 B, 131(2), 205-214 (2011).
- 4) 宇野亨, FDTD 法による電磁界解析およびアンテナ解 析, (コロナ社, 東京, 1998), pp.1-274.